

Compl. of BD 234, BD 236, BD 238

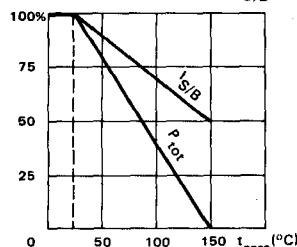
PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

These transistors are intended for complementary or quasi complementary symmetry amplifiers : audio driver, audio output stages up to 10 W, convergence and vertical deflection circuits in TV receivers.

Ces transistors sont destinés aux amplificateurs à symétrie complémentaire ou quasi complémentaire : étages driver, étages de sortie BF jusqu'à 10 W, circuits de convergence et de déviation verticale en télévision.

V_{CEO}	45 V	BD 233
	60 V	BD 235
	80 V	BD 237
I_C	2 A	
P_{tot}	25 W	
$R_{th(j-c)}$	5°C/W	max
h_{21E} (1 A)	25	min
f_T	3 MHz	min

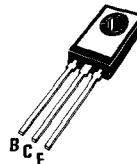
Dissipation and I_S/B derating
Variation de dissipation et de I_S/B



Plastic case
Boîtier plastique

TO-126 – See outline drawing CB-16 on last pages

Voir dessin côté CB-16 dernières pages



Weight : 0,7 g.
Masse

Collector is connected to metal part of case
Le collecteur est relié à la partie métallique du boîtier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

$t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

		BD 233	BD 235	BD 237	
Collector-base voltage Tension collecteur-base	V_{CBO}	45	60	100	V
Collector-emitter voltage Tension collecteur-émetteur	V_{CEO}	45	60	80	V
Collector-emitter voltage $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$	V_{CER}	45	60	100	V
Emitter-base voltage Tension émetteur-base	V_{EBO}	5	5	5	V
Collector current Courant collecteur	I_C	2	2	2	A
Peak collector current Courant de crête de collecteur	I_{CM}	6	6	6	A
Base current Courant base	I_B	0,3	0,3	0,3	A
Power dissipation Dissipation de puissance	P_{tot}	25	25	25	W
Junction temperature Température de jonction	max	t_j	150	150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature Température de stockage	min max	t_{stg}	-55 +150	-55 +150	$^{\circ}\text{C}$

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES STATIQUES
 $t_{case} = 25^\circ\text{C}$ (Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

	Test conditions Conditions de mesure			Min.	Typ.	Max.
Collector-base cut-off current <i>Courant résiduel collecteur-base</i>	$V_{CB} = 45 \text{ V}$ $I_E = 0$	I_{CBO}	BD233		100	μA
	$V_{CB} = 60 \text{ V}$ $I_E = 0$		BD 235		100	μA
	$V_{CB} = 100 \text{ V}$ $I_E = 0$		BD 237		100	μA
	$V_{CB} = 45 \text{ V}$ $I_E = 0$ $t_{case} = 150^\circ\text{C}$		BD 233		3	mA
	$V_{CB} = 60 \text{ V}$ $I_E = 0$ $t_{case} = 150^\circ\text{C}$		BD 235		3	mA
	$V_{CB} = 100 \text{ V}$ $I_E = 0$ $t_{case} = 150^\circ\text{C}$		BD 237		3	mA
	$V_{EB} = 5 \text{ V}$ $I_C = 0$		I_{EBO}		1	mA
Collector-emitter breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-émetteur</i>	$I_C = 100 \text{ mA}$ $I_B = 0$	$V_{CEO(\text{sus})}^*$	BD 233	45		V
			BD 235	60		V
			BD 237	80		V
Static forward current transfer ratio <i>Valeur statique du rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = 2 \text{ V}$ $I_C = 1 \text{ A}$	h_{21E}^*		25		
	$V_{CE} = 2 \text{ V}$ $I_C = 0,15 \text{ A}$		BD 233	40	250	
			BD 235	40	250	
			BD 237	40	160	
Collector-emitter saturation voltage <i>Tension de saturation collecteur-émetteur</i>	$I_C = 1 \text{ A}$ $I_B = 0,1 \text{ A}$	V_{CEsat}^*			0,6	V
Base-emitter voltage <i>Tension base-émetteur</i>	$V_{CE} = 2 \text{ V}$ $I_C = 1 \text{ A}$	V_{BE}^*			1,3	V

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

Transition frequency <i>Fréquence de transition</i>	$V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 0,25 \text{ A}$ $f = 1 \text{ MHz}$	f_T		3		MHz
--	--	-------	--	---	--	-----

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance <i>Résistance thermique (ionction-boîtier)</i>		$R_{th(j-c)}$		5	$^\circ\text{C/W}$
--	--	---------------	--	---	--------------------

* Pulsed $t_p = 300 \mu\text{s}$ $\delta \leq 2 \%$
Impulsions

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

